

Germanium-Transistoren für NF-Verstärker und Schalteranwendungen

Type	Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ \text{C} - 5 \text{ grd}$				Höchstwerte				Bauform	Verwendungszweck
	Stromverstärkung h_{21e}	Kollektorreststrom $I_{CEO} [\mu\text{A}]$ ($-I_{CBO}$)	Rauschfaktor $F [\text{dB}]$ (T_1) (μS)	Kollektorrestspannung $+U_{ECS} [\text{V}]$	Kollektorspannung $-U_{CE} [\text{V}]$ (U_{CEV})	Kollektorstrom $-I_C [\text{mA}]$	Wärme-widerstand $R_{th} \left[\frac{\text{grd}}{\text{mW}} \right]$ ($R_{thi} \left[\frac{\text{grd}}{\text{W}} \right]$)	Sperrschichttemperatur $\vartheta_j [^\circ\text{C}]$		
GC 100	> 18	< 800	< 25	—	8	15	< 1,0	75	17	NF-Vorstufen
GC 101	> 18	< 800	< 10	—	8	15	< 1,0	75	17	NF-Vorstufen rauscharm
GS 100	> 29	(≤ 15)	(< 3)	< 0,50	> 15	50	< 1,0	75	17	Für mittelschnellen Schaltbetrieb
GS 109	> 29	(< 15)	($< 1,5$)	< 0,55	> 15	200	< 0,5	85	13	Schalter für mittlere Geschwindigkeit in logischen Schaltungen
GS 110	> 29	(< 15)	($< 1,5$)	< 0,55	> 15	200	< 0,5	85	13	
GS 111	> 29	(< 15)	($< 1,2$)	< 0,55	> 15	200	< 0,5	85	13	
GS 112	> 29	(< 15)	(< 1)	< 0,55	> 15	200	< 0,5	85	13	
GC 111	> 10	800	—	—	(80)	125	< 0,43	75	13	NF-Transistor für hohe
GC 112	> 10	800	—	—	(90)	125	< 0,43	75	13	Spitzenspannungen
GC 115	10 - 22	< 600	< 25	—	15	125	< 0,43	75	13	NF-Vor- und Treiberstufen
GC 116	> 18	< 600	< 25	—	15	125	< 0,43	75	13	
GC 117	> 18	< 600	< 10	—	15	125	< 0,43	75	13	rauscharme NF-Vorstufen
GC 118	> 18	< 600	< 5	—	15	50	< 0,43	75	13	
GC 120	—	< 600	< 25	< 0,55	20	150	< 0,43	75	14	NF-Endstufen kleiner
GC 121	—	—	< 25	< 0,55	20	150	< 0,43	75	14	Leistung
GC 122	—	—	—	< 0,55	30	150	< 0,43	75	14	30 V-Schalttransistor
GC 123	—	—	—	< 0,55	60	150	< 0,43	75	14	60 V-Schalttransistor
GC 216*)	> 18	(< 15)	< 25	< 0,55	(15)	100	$P_C = 75 \text{ mW}$	75	12	Treiberstufen für d. Mikro-modulteknik
GC 217*)	> 18	(< 15)	< 10	< 0,55	(15)	100	$P_C = 75 \text{ mW}$	75	12	
GC 221*)	> 18	(< 18)	—	< 0,55	(15)	100	$P_C = 75 \text{ mW}$	75	12	NF-Endstufen
GC 223*)	> 18	(< 18)	—	< 0,55	(66)	100	$P_C = 75 \text{ mW}$	75	12	60 V-Schalttransistor
GC 300*)	> 18	≤ 500	—	—	20	500	(75)	75	13	NF-Treiber- und Endstufen mittlerer Leistung
GC 301*)	> 18	≤ 500	—	—	32	500	(75)	75	13	

Germanium-Leistungstransistoren für Endstufen und Schalteranwendungen

Type	Basisstrom $-I_B [\text{mA}]$ für $-I_C = 100 \text{ mA}$ ($-I_C = 200 \text{ mA}$)	Kollektorreststrom		$-U_{CBO} [\text{V}]$	$-U_{CER} [\text{V}]$	$-I_C [\text{A}]$	$R_{thi} \left[\frac{\text{grd}}{\text{W}} \right]$	$\vartheta_j [^\circ\text{C}]$	Bauform	Verwendungszweck
		$-I_{CEO} [\text{mA}]$	$-I_{CBO} [\mu\text{A}]$							
GD 100	≤ 10	< 1	< 30	20	18	1	< 15	75	15	NF-Leistungs-Endstufen
GD 110	≤ 5	< 1	< 30	20	18	1	< 15	75	15	NF-Leistungs-Endstufen
GD 120	≤ 5	< 1	< 30	33	30	1	< 15	75	15	30 V-Schalttransistor
GD 130	≤ 5	< 1	< 30	66	58	1	< 15	75	15	60 V-Schalttransistor
GD 150	(≤ 20)	< 1,5	< 50	20	18	3	< 7,5	75	15	NF-Leistungs-Endstufen
GD 160	(≤ 10)	< 1,5	< 50	20	18	3	< 7,5	75	15	NF-Leistungs-Endstufen
GD 170	(≤ 10)	< 1,5	< 50	33	30	3	< 7,5	75	15	30 V-Schalttransistor
GD 180	(≤ 10)	< 1,5	< 50	66	60	3	< 7,5	75	15	60 V-Schalttransistor
GD 200*)	—	≤ 3	≤ 150	30	20	6	< 2	75	16	15 W-Transistor für Regelzwecke
GD 210*)	—	≤ 3	≤ 150	60	48	6	< 2	75	16	
GD 220*)	—	≤ 3	≤ 150	80	60	6	< 2	75	16	

*) in Entwicklung